



国家电网
STATE GRID

北京智芯微电子科技有限公司
BEIJING SMARTCHIP MICROELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.



SCA200 外设兼容性列表

文档版本

01

发布日期

2022-02-26

版权所有 © 北京智芯微电子科技有限公司 2021。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受北京智芯微电子科技有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，北京智芯微电子科技有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

北京智芯微电子科技有限公司

地址：北京市昌平区中科云谷园

前言

概述

本文档主要介绍 SCA200 外设兼容性器件列表。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 单板硬件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
2022-2-26	01	第一版发布

目录

1 QSPI NOR	1
2 QSPI Nand	1
3 eMMC	1
4 DDR	2

智芯(上海)科技有限公司

1 QSPI NOR

品牌	型号	容量	电压	SPI 时钟	封装	温度
XMC	xm25qu128cwiq	128M bit	1.8 V	133MHz	WSON-8 5x6mm	-40-85°
MXIC	mx25u25643gzni00	256M bit	1.8 V	133MHz	WSON-8 5x6mm	-40-85°
Winbond	w25q256jweiq	256M bit	1.8 V	133MHz	WSON-8 8x6mm	-40-85°
Winbond	w25q256jweim	256M bit	1.8 V	133MHz	WSON-8 8x6mm	-40-85°
GigaDevice	gd25lt256ebir	256M bit	1.8 V	200MHz_30PF	TFBGA-24ball (5x5)	-40-85°

2 QSPI Nand

品牌	型号	容量	电压	SPI 时钟	封装	温度
GigaDevice	gd5f1gq5reyig	1G bit	1.8 V	104MHz_30PF	WSON-8 8x6mm	-40-85°
GigaDevice	gd5f4gm5rfyig	4G bit	1.8 V	120MHz_30PF	WSON-8 8x6mm	-40-85°
Winbond	w25n01jwzeig	1G bit	1.8 V	166MHz	WSON-8 8x6mm	-40-85°
Winbond	w25n01jwzeit	1G bit	1.8 V	166MHz	WSON-8 8x6mm	-40-85°

3 eMMC

品牌	型号	容量	eMMC 等级
Hynix	H26M41208HPR	8GB	MMC v5.1
Hynix	H26M31001HPR	4GB	MMC v5.1
Sandisk	SDIN8DE2	8GB	MMC v5.1
Toshiba	THGBMHG6C1LBAIL	8GB	MMC v5.1
Toshiba	THGBMNG5D1LBAIL	4GB	MMC v5.1
Samsung	KLMBG2JETD-B041	32GB	MMC v5.1
Samsung	KLM8G1GETF-B041	8GB	MMC v5.1
旺宏	MX52LM04A11	4GB	MMC v5.1
江波龙	FEMDRM008G	8GB	MMC v5.1

4 DDR

品牌	型号	DDR 容量	类型	温度
Micron	MT40A256M16LY-062E-F	3200Mbps 4Gb	DDR4	0-95°
SKhynix	H5AN8G6NDJR-XNC	3200Mbps 8Gb	DDR4	0-95°
Samsung	K4A4G165WF-BCWE	3200 Mbps 4Gb	DDR4	0-95°
Samsung	K4A8G165WB-BCRC	2400 Mbps 8Gb	DDR4	0-95°
Gigadevice	GDQ2BFAA-CJ	3200Mbps 4Gb	DDR4	0-95°